

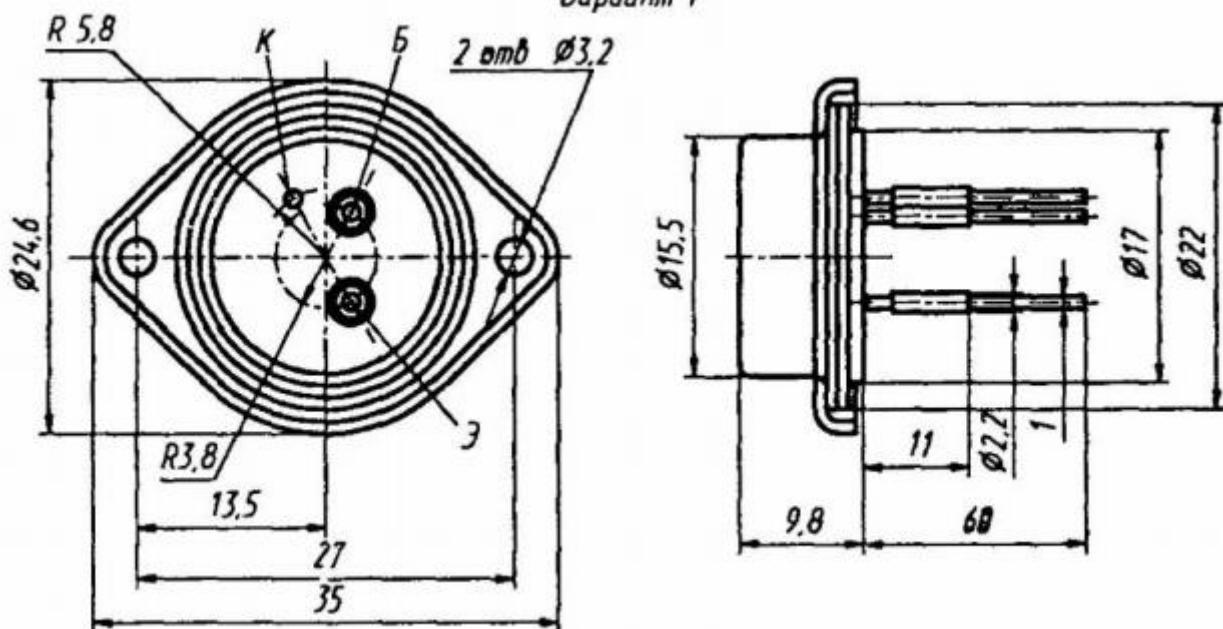
П605, П605А, П606, П606А

Транзисторы германиевые структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и импульсных каскадах низкой и высокой частоты (до 30 МГц). Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими (вариант 1) и жесткими (вариант 2) выводами. Тип прибора указан на корпусе.

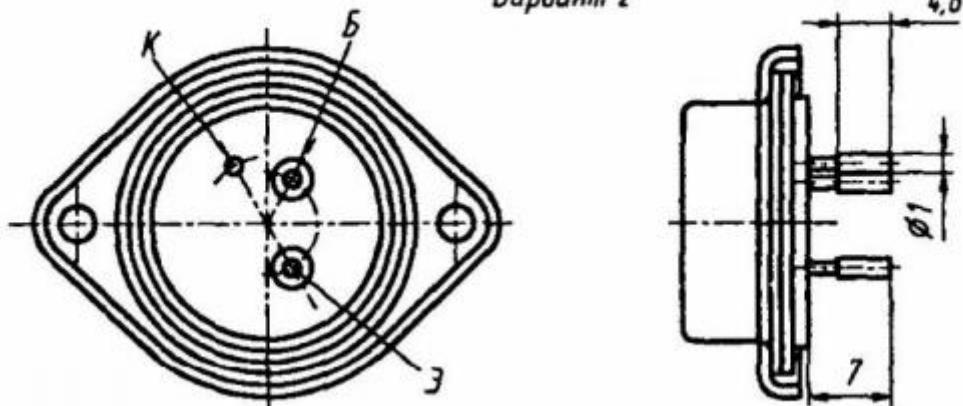
Масса транзистора с жесткими выводами не более 11 г, с гибкими выводами не более 12 г.

П605, П605А, П606, П606А

Вариант 1



Вариант 2



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $f = 0,1 \dots 10$ кГц:

$T = +20$ °C:

$U_{K3} = 3$ В, $I_K = 0,5$ А для П605, П606	20...35*...60
$U_{K3} = 3$ В, $I_K = 0,5$ А для П605А, П606А	50...75*...120
$U_{K3} = 7$ В, $I_K = 15$ мА для П605, П605А, П606, П606А	20...30*...50*

$T = -60$ °C:

$U_{K3} = 3$ В, $I_K = 0,5$ А для П605, П606	14...84
$U_{K3} = 3$ В, $I_K = 0,5$ А для П605А, П606А	25...168

$T = +70$ °C

0,5...1,5	значения при
$T = +20$ °C	

Модуль коэффициента передачи тока на вы-
сокой частоте при $U_{K3} = 10$ В, $I_3 = 50$ А,

$f = 10$ МГц для П606, П606А

3...5,5*...7*

Граничное напряжение при $I_3 = 0,3$ А,

$t_u = 5$ мкс, $f = 0,1 \dots 10$ кГц:

П605, П605А	35...45*...55* В
П606, П606А	20...30*...40* В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:

при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 60$ мА для П605, П606	0,4*...0,7*...2 В
при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 30$ мА для П605А, П606А	0,4*...0,7*...2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер:

при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 60$ мА для П605, П606	0,3*...0,5*... 1,2 В
при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 30$ мА для П605А, П606А	0,3*...0,5*... 1,2 В

Постоянная времени цепи обратной связи

при $E_K = 20$ В, $I_3 = 50$ мА, $f = 5$ МГц

40*...80*...
500 нс

Время включения при $t_u \geq t_{VCL}$, $f = 1 \dots 10$ кГц:

$U_{K3} = 20$ В, $I_K = 0,5$ мА, $I_B = 60$ мА для П605, П606	0,06*...0,1*... 0,3 мкс
------------------------------------------------------------------------	----------------------------

$U_{K3} = 20$ В, $I_K = 0,5$ мА, $I_B = 30$ мА для П605А, П606А, не более	0,35 мкс
------------------------------------------------------------------------------------	----------

Время рассасывания при $f = 1 \dots 10$ кГц:

$U_{K3} = 20$ В, $I_K = 0,5$ А, $I_B = 60$ мА для П605,

П606 0,4*...1*...3 мкс

$U_{кэ} = 20$ В, $I_k = 0,5$ мА, $I_b = 30$ мА

для П605А, П606А, не более 4 мкс

Обратный ток коллектора, не более:

при $T = +20$ °С:

$U_{кб} = 45$ В для П605, П605А 2 мА

$U_{кб} = 35$ В для П606, П606А 2 мА

при $T = +70$ °С:

$U_{кб} = 40$ В для П605, П605А 8 мА

$U_{кб} = 30$ В для П606, П606А 8 мА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $R_{бэ} = 100$ Ом, не более:

$U_{кэ} = 40$ В для П605, П605А 3 мА

$U_{кэ} = 25$ В для П606, П606А 3 мА

Обратный ток эмиттера, не более:

$T = +20$ °С:

$U_{эб} = 1$ В для П605, П605А 1 мА

$U_{эб} = 0,5$ В для П606, П606А 1 мА

$T = +70$ °С:

$U_{эб} = 1$ В для П605, П605А 2 мА

$U_{эб} = 0,5$ В для П606, П606А 2 мА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{кб} = 20$ В, $f = 5$ МГц 50*...70*...
130 пФ

Емкость эмиттерного перехода

при $U_{эб} = 0,5$ В, $f = 5$ МГц, не более 2000* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при $R_{эб} \leq 100$ Ом, $T = -60...+20$ °С:

П605, П605А 40 В

П606, П606А 20 В

при $R_{эб} \leq 10$ Ом, $T = +70$ °С:

П605, П605А 20 В

П606, П606А 15 В

при заданном обратном напряжении эмиттер—база:

$T = -60...+20$ °С:

П605, П605А 45 В

П606, П606А 35 В

$T = +70$ °С:

П605, П605А	40 В
П606, П606А	30 В
Постоянное напряжение коллектор—база:	
$T = -60 \dots +20$ °С:	
П605, П605А	45 В
П606, П606А	35 В
$T = +70$ °С:	
П605, П605А	40 В
П606, П606А	30 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
П605, П605А	1 В
П606, П606А	0,5 В
Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 10$ мс, $Q \geq 2$	
$T = -60 \dots +20$ °С	1,5 А
Импульсный ток базы при $t_i \leq 10$ мс, $Q \geq 2$	
$T = +70$ °С	0,5 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора ¹ :	
без теплоотвода:	
$T = -60 \dots +20$ °С	0,5 Вт
$T = +70$ °С	0,3 Вт
с теплоотводом при $R_{T(п-к)} \leq 15$ °С/Вт:	
$T = -60 \dots +20$ °С	3 Вт
$T = +70$ °С	0,75 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	15 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда (без теплоотвода)	35 °С/Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+85 °С
Температура окружающей среды	$-60 \dots T_k =$ = +70 °С

¹ Рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T = +25 \dots +70$ °С и без теплоотвода при $T = +60 \dots +70$ °С рассчитывается по формуле

$$P_{k, \text{ср, макс}} = (85 - T) / (R_{T(п-к)} + R_{T(к-с)}), \text{ Вт.}$$

При эксплуатации транзисторы должны крепиться с помощью накидного фланца. Расстояние от корпуса транзистора до места пайки вывода не менее 20 мм для варианта с гибкими выводами и не менее 5 мм для варианта с жесткими выводами.